

## S13003D

## 硅 NPN 大功率晶体管

**\* 主要用途 :**

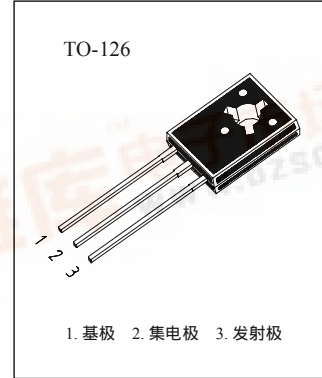
电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

**\* 主要特点 :**

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

**\* 封装形式 :**

TO-126



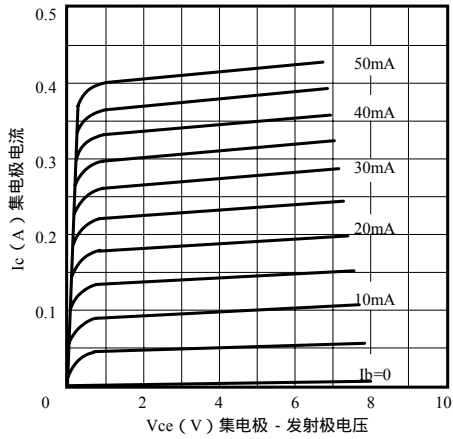
**极限值 :** (  $T_c=25$  )

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极 - 发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	400	V
集电极 - 基极击穿电压	$BV_{CBO}$	600	V
发射极 - 基极击穿电压	$BV_{EBO}$	9	V
最大集电极直流电流	$I_{cm}$	1.5	A
最大耗散功率	$P_{cm}$	30	W
最高结温	$T_{jm}$	150	
贮存温度	$T_{stg}$	- 55 ~ 150	

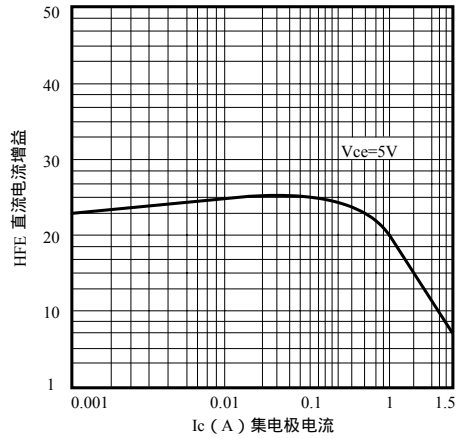
**电特性 :** (  $T_c=25$  )

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
集电极 - 发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_c=1mA ; I_B=0$	400		V
集电极 - 基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_c=1mA ; I_E=0$	600		V
发射极 - 基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=1mA ; I_C=0$	9		V
集电极 - 发射极反向漏电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=350V ; I_B=0$		20	$\mu A$
集电极 - 基极反向漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=550V ; I_E=0$		10	$\mu A$
发射极 - 基极反向漏电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7V ; I_C=0$		10	$\mu A$
共发射极直流电流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=5V ; I_C=0.2A$	10	35	
集电极 - 发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1A ; I_B=0.5A$		0.6	V
下降时间	$t_f$	$I_C=1A ; I_{B1}=I_{B2}=0.2A ; V_{CE}=300V$		0.3	$\mu S$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10V ; I_C=0.1A ; f=1MHz$		8	MHz

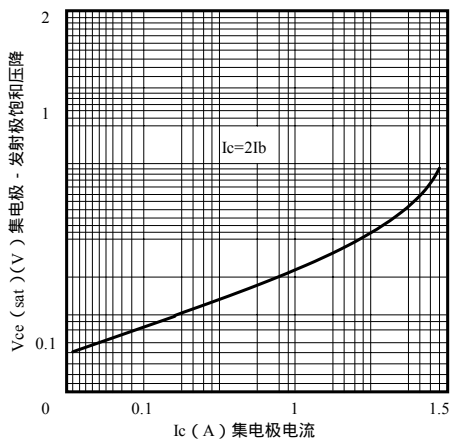
静态输出特性



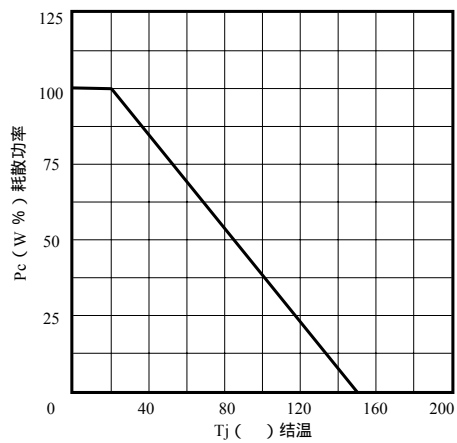
HFE 直流电流增益 -  $I_c$  集电极电流



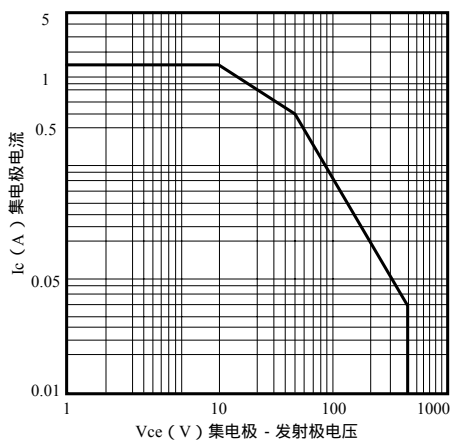
$V_{ce(sat)}$  集电极 - 发射极饱和压降 -  $I_c$  集电极电流



$P_c$  耗散功率 -  $T_j$  结温

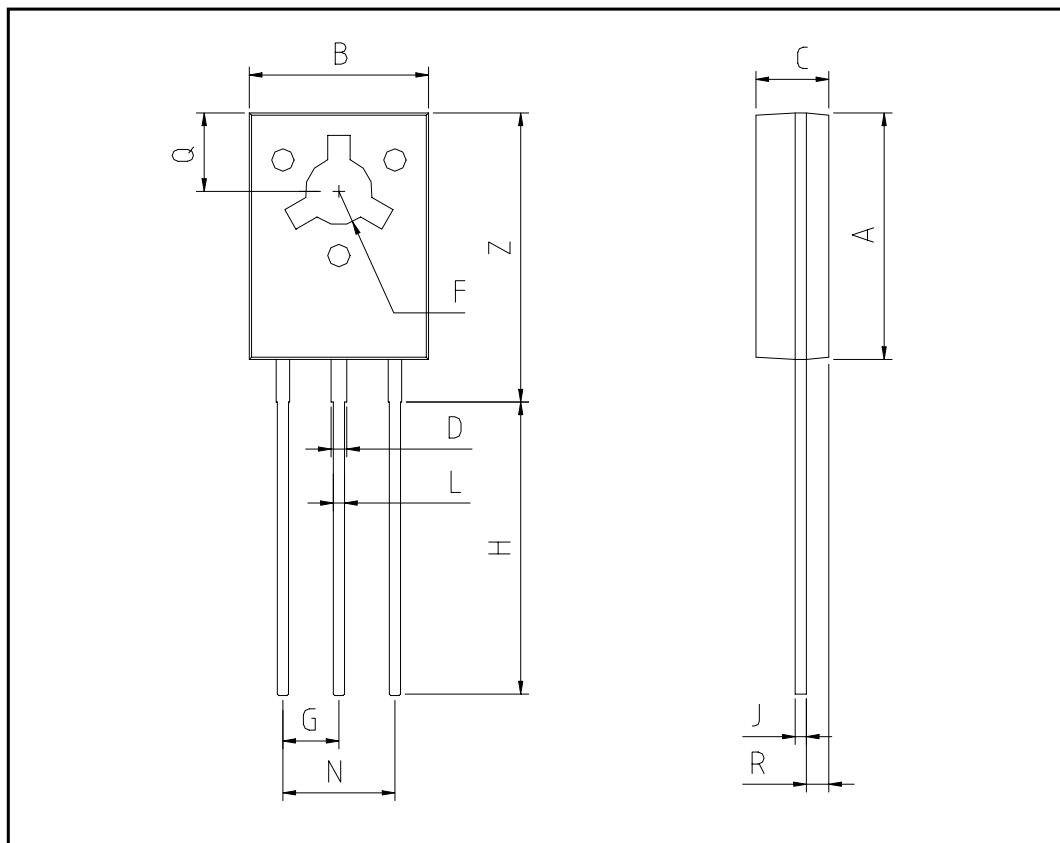


SOA (DC) 安全工作区



# TO - 126 外形尺寸图

单位：mm



符号	最小值	典型值	最大值
A	9.0	10	11
B	7.05	8	8.05
C	2.4	2.5	2.8
D	1.4	1.5	1.6
F	3.15	φ3.2	3.25
G		2.3	
H		13	
J	0.48	0.5	0.55
K			
L	0.65	0.75	0.85
N		4.6	
P			
Q	3.8	3.9	4.0
R	0.9	1	1.1
S			
Z	13.5	14	14.5

